

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2020年4月2日(02.04.2020)



(10) 国際公開番号

WO 2020/066114 A1

(51) 国際特許分類:
C23C 14/34 (2006.01) *C22C 5/04* (2006.01)
B22F 1/00 (2006.01) *G11B 5/738* (2006.01)
C22C 1/05 (2006.01) *G11B 5/84* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2019/019571

(22) 国際出願日: 2019年5月16日(16.05.2019)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2018-178381 2018年9月25日(25.09.2018) JP

(71) 出願人: J X 金属株式会社 (JX NIPPON MINING & METALS CORPORATION) [JP/JP];
〒1008164 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 岩淵 靖幸 (IWABUCHI, Yasuyuki);
〒3191535 茨城県北茨城市華川町白場187番地4 J X 金属株式会社磯原工場内 Ibaraki (JP). 佐藤 敦 (SATO, Atsushi); 〒3191535 茨城県北茨城市華川町白場187番地4 J X 金属株式会社磯原工場内 Ibaraki (JP). 下宿 彰 (SHIMOJUKU, Akira); 〒3191535 茨城県北茨城市華川町白場187番地4 J X 金属株式会社磯原工場内 Ibaraki (JP). 清水 正義 (SHIMIZU, Masayoshi); 〒3191535 茨城県北茨城市華川町白場187番地4 J X 金属株式会社磯原工場内 Ibaraki (JP).

(74) 代理人: アクシス国際特許業務法人 (AXIS PATENT INTERNATIONAL); 〒1050004 東京都港区新橋二丁目6番2号 新橋アイマークビル Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH,

KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

(54) Title: SPUTTERING TARGET AND POWDER FOR PRODUCING SPUTTERING TARGET

(54) 発明の名称: スパッタリングターゲット及びスパッタリングターゲットを製造するための粉体

(57) Abstract: The present invention provides a sputtering target which contains Ru and boron. A sputtering target which contains Ru as a main component, while containing a composite oxide that contains boron and has a higher melting point than B₂O₃.

(57) 要約: Ru 及びホウ素を含むスパッタリングターゲットを提供すること。Ru を主成分とするスパッタリングターゲットであって、B₂O₃よりも高い融点をもち且つホウ素を含む複合酸化物を含有する、該ターゲット。



WO 2020/066114 A1